B01 宇宙形状可変鏡における変位の連成特性に関する研究

武田 真司 (東工大),小出 紗瑛 (東工大),大本 圭祐 (東工大),坂本 啓 (東工大) 田中 宏明 (防衛大),石村 康生 (早稲田大),大熊 政明 (東工大)

1. 序 論

電波天文衛星が100GHz を超える高周波電波の観測を行 うために、衛星に搭載する大型アンテナの高い鏡面精度の 達成が求められる.しかし,展開構造において展開後の形 状を高精度に保証することは難しい. そこで, 鏡面形状を 能動的に変形させ、電波の行路差を低減することで、展開 後の形状 誤差を補正し、結果として高い鏡面精度を達成す る形状可変鏡の研究が行われている.電波天文衛星に用い る展開式大型形状可変鏡の例として, NASA が 2021 年打 ち上げ予定の、100THz 帯電波観測を目的とした JWST が ある [1.2]. JWST は主鏡と副鏡の2枚のアンテナを組み合 わせたカセグレン式のアンテナシステムを搭載している. JWST は主鏡と副鏡ともに形状可変鏡であり、極めて複雑 なシステムとなっている. これに対して著者らは, 100GHz 帯という JWST より 10³ 倍波長が長い電波観測を目指し, 図 1.1 のようにカセグレン式で副鏡のみを形状可変とする システムを提案し、試作と地上検証を行ってきている[3-9]. 一般に主鏡よりも顕著に小型な副鏡のみを形状可変とする ことで,大型の主鏡を形状可変とする場合と比べ駆動機構 が小型化・単純化できることが期待される.

これまでに製作された形状可変副鏡のプロトタイプを図 1.2 に示す.本プロトタイプは図 1.2(b) のスリット入り凸 型鏡面と、図 1.2(c) のスマートアクチュエータ6本から構 成される [3,4]. 図 1.2(c) 右上のような 3 次元座標系を定義 する. スリット入り凸型鏡面は, 直径 200mm, 板厚 0.5mm のアルミニウム製で、深さ70mmのスリットにより6つの 領域 (チャンネル,以降 CH) に分割されている.スマート アクチュエータは積層型圧電アクチュエータと変位拡大機 構から構成される.積層型圧電アクチュエータは電圧を印 加することで z 軸方向に変形する.その変形を変位拡大機 構により10倍に拡大し、先端変位zを出力する.6分割 された凸型鏡面の裏からスマートアクチュエータで押すこ とで鏡面形状を変形させる. このスマートアクチュエータ への要求は先端変位 z の最大ストロークが 1mm 程度,分 解能が 1µm 程度である.スマートアクチュータの全長は 160mmで、変位拡大機構と積層型圧電アクチュエータの ケースは低熱膨張合金 IC-LTX(熱膨張係数 0.02ppm/K) に より製作されている.また,積層型圧電アクチュエータの 圧電素子の熱膨張係数は -1.1ppm/K である. 大本ら [8] に



Fig. 1.1 考案されている形状可変アンテナシステム



よると、低熱膨張合金 IC-LTX の熱膨張係数は圧電素子の 熱膨張係数に比べて十分小さいため、低熱膨張合金 IC-LTX を用いた変位拡大機構と積層型圧電アクチュエータのケー スの熱膨張を無視できると仮定している.一つのスマート アクチュエータには、積層型圧電アクチュエータの圧電素 子とそのケースの外側の2箇所にひずみゲージが貼り付け られている.どちらのひずみゲージもz軸方向のひずみを 計測する.ケースに貼り付けたひずみゲージは、ケース自 体の熱膨張を無視できると仮定するため、ひずみゲージの 熱変形誤差のみを計測している.したがって、二つのひず



Fig. 1.3 スマートアクチュエータ単体のヒステリシス 特性

みゲージの値の差をとることで,ひずみゲージの熱変形誤 差を相殺できる.この二つのひずみゲージの値の差を圧電 ひずみ ε とする.この圧電ひずみ ε は,圧電素子の電圧印 加による伸びと,圧電素子の熱膨張分のひずみを含む.ス マートアクチュエータ単体に印加電圧を与えた時の先端変 位zと圧電ひずみ ε のグラフを図 1.3 に示す.図 1.3(a)よ り印加電圧と先端変位zにはヒステリシスが見られるが, 図 1.3(b)より印加電圧と圧電ひずみ ε でも同様のヒステリ シスが見られる.これよりアクチュエータ単体では圧電ひ ずみ ε を読むことで先端変位zを一意に推定された.

高精度形状可変鏡実現のため、本プロトタイプを用い た地上実験により、熱変形や個体差による影響を低減させ る設計改善と評価が行われてきた [3-9].また、図 1.2(a)の ようにスマートアクチュエータと凸型鏡面を統合した状態 で、鏡面の z 軸方向変位 (以降、鏡面変位)z を一定に保つ、 図 1.4 のようなフィードバックシステムが開発された [8]. このシステムは鏡面変位 z と圧電ひずみ ε が一対一に対応 しているという仮定のもとに、目標鏡面変位 z に対応した 圧電ひずみ ε で一定に保つ制御を行っている.また、この システムはある一つの CH の鏡面変位 z を得るために、そ の CH の圧電ひずみ ε のみを調整している.すなわち、各 CH それぞれを独立的に制御している.これにより、スマー トアクチュエータ単体の圧電素子起因のヒステリシスは除 去可能である.しかし、凸型鏡面を統合した時の、機構起







Fig. 2.1 計測装置





因のヒステリシスの問題を小出らが示唆した [9].

そこで本研究では,100GHz帯の電波観測に向けた形状 可変副鏡のプロトタイプを用いた実験で,圧電ひずみ計測 フィードバック系による鏡面変位のヒステリシス除去性能 の評価を目的とする.これを達成するために,本研究では (i)圧電ひずみと鏡面変位の対応関係の評価,および(ii)圧 電ひずみと鏡面変位関係の再現性の評価を行う.

2. 圧電ひずみと鏡面変位の対応関係評価

2.1 実験の目的・方法 本章では、スマートア クチュエータ6本と凸型鏡面を統合した状態で、圧電ひず み ε と鏡面変位zの対応関係を評価する.まず、変位の連 成特性計測を行い、連成特性による圧電ひずみ ε と鏡面変 位zへの影響を定量化する.続いて、フィードバック制御 実験を行い、連成特性がフィードバック制御による形状制 御に与える影響を定量化する.ここで連成特性とは、6つ の領域に分割された凸型鏡面において、一つの鏡面領域が



 Fig. 2.3
 ゼロ膨張ガラスを用いた計測系の熱変形校正

 の様子



Fig. 2.4 鏡面変位の計測位置

他鏡面領域の変形の影響を受けることと定義する. 圧電ひ ずみ *ε* の計測については,先行研究と同様に,積層型圧電 アクチュエータのケース自体の熱膨張を無視できると仮定 する.

スマートアクチュエータの圧電ひずみ ε と鏡面変位 z の計 測には図 2.1 の計測装置を用い,計測系ダイアグラムは図 2.2 の通りである.2本のスライダにレーザー変位計を取り 付け,スライダーを駆動させることで鏡面内の各点を計測 する.熱電対と温度データロガーによって恒温ブース内の 温度をモニターし,温度定常状態での圧電ひずみ ε と鏡面 変位 z を計測する.また治具の熱変形,およびレーザー変 位計の温度特性による影響を校正するため,図 2.3 のよう に熱膨張係数がほぼ 0 であるゼロ膨張ガラスを計測する.

図 2.4 のように、スリットにより分割された凸型鏡面 の 6 つの領域を、それぞれ CH1 から CH6 と振り分ける. 各 CH の鏡面裏には一つずつスマートアクチュエータが配 置されている.これらスマートアクチュエータの頂点の真 上をレーザー変位計により計測することで、CH1-6 の鏡面 変位 z_i (i = 1, ..., 6)を得る.なお、CH1-6 の圧電ひずみを ε_i (i = 1, ..., 6)とする.計測結果の鏡面変位 zに関するエ ラーバーはレーザー変位計の測定精度、および治具の熱変



(a)CH2-6が0Vを基準としたCH2-6の鏡面変位



(b)CH2-6が150Vを基準としたCH2-6の鏡面変位

Fig. 2.5 CH1の鏡面変位に対する CH2-6 の鏡面変位

形から推定される計測誤差を示す.また圧電ひずみに関す るエラーバーはひずみゲージの測定精度から推定される計 測誤差を示す.

2.2 変位の連成特性計測 初めに、CH1 に最大 約 1mm までの鏡面変位 z_1 を与えていく時の、隣合う CH2-6 の鏡面変位 z_i (i = 2, ..., 6)を計測する.計測パターンは次 の二種類である.第一に CH1 が 0V, CH2-6 が 0V 時のそ れぞれの鏡面位置 zを基準とする場合の計測結果を図 2.5(a) に示す.第二に CH1 が 0V, CH2-6 が 150V 時のそれぞれ の鏡面位置 zを基準とする場合の計測結果を図 2.5(b) に示 す.どちらのパターンでも CH1 の約 1mm までの上昇に比 例して、CH1 の両隣りに位置する CH2 と CH6 の鏡面が約 0.02mm 下降する傾向が見られた.これは 1 つの鏡面の変 形に対して,鏡面全体のひずみエネルギーが最小化するよ うに変形したためと考えられる.

続いて、CH2-6の印加電圧を全て 0V, 75V, 150V に揃え たそれぞれのパターンで、CH1の圧電ひずみ ε_1 に対する CH1の鏡面変位 z_1 の計測結果を図 2.6 に示す、鏡面位置 zと圧電ひずみ ε はすべて CH1 が 0V, CH2-6 が 0V 時を基



Fig. 2.6 他チャンネル電圧の依存性

準としている.異なる CH2-6 の印加電圧による, CH1 の 圧電ひずみ ε1 と鏡面変位 z1 のグラフの傾きに違いは見ら れなかった.しかし、同じ圧電ひずみ ε_1 において、CH2-6 の印加電圧が大きいほど鏡面変位 z1 が小さい. CH2-6 の 印加電圧が 0V と 150V では同じ圧電ひずみ E1 に対して, 鏡面変位 z1 に約 0.04mm の差が見られた. この計測結果よ り、一つの CH の圧電ひずみ ε と鏡面変位 z は一対一に対 応しておらず,他 CH の印加電圧に依存した機構起因のヒ ステリシスが明らかになった. これは鏡面変位の連成によ り、スマートアクチュエータが、鏡面から受ける反力が増 加したためと考えられる. 凸型鏡面と統合した状態では, 各 CH をそれぞれ独立的に制御する現フィードバックシス テムでは、連成特性による機構起因のヒステリシス除去は 難しいと考察される.したがって,次節では連成特性影響 下でのフィードバック制御実験を行い,現フィードバック システムの機構起因のヒステリシス除去可能性を定量的に 評価する.

2.3 フィードバック制御実験 図 2.7 にフィー ドバック制御実験の結果を示す. CH1 の目標鏡面変位を 0.4mm とする. 図 2.7(a) は CH2-6 の印加電圧に対する CH1 の圧電ひずみ ε_1 を表しており, 圧電ひずみはほぼ一定値 に制御されている. 図 2.7(b) は CH2-6 の印加電圧に対す る CH1 の鏡面変位 z_1 を表しており, CH2-6 の印加電圧が 上昇するほど CH1 の鏡面変位 z_1 は減少し, 0V と 150V で は鏡面変位 z_1 に約 0.04mm の減少が見られた. 実験結果よ り, 圧電ひずみフィードバック系では,約 0.04mm の鏡面 変位誤差が含まれることが明らかになった.

本章の実験結果より、ある CH の圧電ひずみ ε と鏡面変 位 zの関係は、他 CH 依存性により一対一に対応していな いことが明らかになった.そこで、次章ではその対応のな さについての再現性を評価する.再現性が確認できれば、 その再現性をもとに 6 つの CH の圧電ひずみ ε_i (i = 1, ..., 6) から各 CH の鏡面変位 z_i (i = 1, ..., 6) が推定でき、機構起 因のヒステリシスが除去可能と評価できる.





3. 圧電ひずみと鏡面変位関係の再現性評価

3.1 実験の目的・方法本章では、圧電ひずみ *ε* と鏡面変位 *z* 関係の再現性評価として、各 CH への電圧印 加順序の違いによる鏡面変位 *z* を定量化する.計測系は第 2.1 章に示したものと同様である.

各 CH への電圧印加順序として図 3.2 の 3 通りの順序で 印加する.印加順序 (i) は CH1-2-6-3-5-4, (ii) は CH4-5-3-6-2-1, (iii) は CH2-3-4-5-6-1 である.はじめ全 CH の印加 電圧が 0V の状態から,各順序で 150V 印加させた時の CH1 の鏡面変位 z_1 を計測する.各順序において,各 CH の初 期鏡面位置をそれぞれ統一するため,計測前に図 3.1 のス マートアクチュエータと鏡面の接触部分にある調整ネジを 用いて,各 CH の初期鏡面位置の調整を行なった.初期鏡 面位置の調整は、レーザー変位計で計測しながら,設定し た鏡面位置 z の ± 0.002mm 以内のズレを許容した.計測 結果の鏡面変位 z に関するエラーバーはレーザー変位計の 測定精度,治具の熱変形から推定される計測誤差,および 許容した初期鏡面位置のズレを示す.



Fig. 3.1 スマートアクチュエータと鏡面の接触部分



Fig. 3.2 電圧印加順序



Fig. 3.3 電圧印加順序の違いによる鏡面変位

3.2 鏡面変位の計測結果 電圧印加順序の違い による CH1 の鏡面変位 z1 の計測結果を図 3.3 に示す.印 加順序 (i) と (ii) で CH1 の鏡面変位 z1 の違いが大きく,印 加順序 (i) のエラーバーの下端と印加順序 (ii) のエラーバー の上端との差から,約 0.01mm の有意な差が見られた.計 測結果より,鏡面変位 z が電圧印加順序に対する経路依存 性が明らかになった.この経路依存性の原因として,鏡面 の変形に分岐が生じるためと考えられる.

本章の実験結果より、鏡面変位zの経路依存性が確認された。第2章で得られた結果も踏まえ、連成特性により、圧電ひずみ ε と鏡面変位zの関係は一対一に対応いておらず、その関係の高精度な再現性が低いことが明らかになった。

4. 結 論

100GHz を超える電波観測を目的とした電波天文衛星を 想定した形状可変副鏡において,圧電ひずみ計測による鏡 面変位のヒステリシス除去可能性評価として,圧電ひずみ と鏡面変位の計測を行い,結果として以下の二つを明らか にした.第一に,提案機構のヒステリシスには、「圧電素子」 と「その他の機構」に起因する二種がある.第二に,圧電 ひずみ計測だけでは,後者の機構起因のヒステリシスを除 去することが難しく,約1μmの分解能要求に対し,機構 由来のヒステリシスが40μm程度と無視できない大きさで ある.今後,設計の改良などが求められる.

本論文で残された課題として,機構/フィードバック系の 改良により,ヒステリシスを除去できるシステムへ改良が 必要である.機構の改良として連成特性を軽減/除去する凸 型鏡面の改良,鏡面変位の直接計測の検討が挙げられる.

謝 辞

本研究は、ISAS/JAXA 戦略的開発研究費「高性能科学 観測にむけた高精度構造・材料の研究開発」の活動の一環 として実施した.

文 献

- M. A. Greenhouse, "The James Webb Space Telescope: Mission Overview and Status", AIAA SPACE 2012 Conference & Exposition, 2012.
- (2) R. M. Warden, "Cryogenic Nano-Actuator for JWST", 38th aerospace Mechanism Symposium, 2006.
- (3)田中宏明,坂本啓,石村康生,稲垣章弥,小木曽望,池田 忠繁,古谷寛,渡辺和樹,及川祐,倉冨剛,「高精度スマート 形状可変鏡試作モデルの開発」,宇宙航空研究開発機構宇 宙科学研究所,2013.
- (4)田中宏明,坂本啓,石村康生,小木曽望,池田忠繁,古谷 寛,渡辺和樹,及川祐,倉冨剛,「高精度形状可変鏡の初期実 験モデルの開発」,第60回宇宙科学技術連合講演会,2014.
- (5) A. Inagaki, H. Sakamoto, H. Tanaka, K. Ishimura, M. Okuma, "Experimental study of reflector shape control under various thermal conditions", 2nd AIAA Spacecraft Structures Conference, AIAA SciTech Forum, 2015.
- (6) K. Gotou, H. Sakamoto, A. Inagaki, H. Tanaka, K. Ishimura, M. Okuma, "Actuator design for space smart reflector to reduce thermal distortion", Transactions of the Japan society for aeronautical and space scientists, aerospace technology Japan, 2016.
- (7) R. Kashiyama, H. Sakamoto, H. Tanaka, K. Ishimura, M. Okuma, "Athermalization of deformable reflector's actuators for radio astronomy satellites", 2018 AIAA Spacecraft Structures Conference, AIAA SciTech Forum, 2018.
- (8) 大本圭祐,「宇宙アンテナ形状制御機構の駆動状態での熱変 形の評価と制御」,第62回宇宙科学技術連合講演会,2018.
- (9)小出紗瑛,「熱膨張律不整合を低減させた形状可変鏡の熱変 形特性計測」,第63回宇宙科学技術連合講演会,2019.